



Home | Contact

European **Patent Office**

English

Deutsch

Français

Quick Search

Advanced Search

Number Search

Last Results list

My patents list

Classification Search

Help

Quick Help

- » Why are some tabs grey for certain documents?
- >> Why does a list of documents with the title Also published as appear sometimes and what are these documents?
- » What does A1, A2, A3 and B mean after an EP publication number, which appears sometimes under the Also published as list?
- » What is a cited document?
- >> Why do I not always see cited documents?
- >> Why do I sometimes see the abstract of a correspondent document?
- >> What is a mosaic?

In my patents list | Print

VAPOR DEPOSITION METHOD

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original c

Patent number:

JP58185767

Publication date:

1983-10-29

Inventor:

NIHEI MASAYASU; others: 03

Applicant:

0

HITACHI SEISAKUSHO KK

Classification:

- international:

C23C13/00

- european:

Application number: JP19820067431 19820423

Priority number(s):

View INPADOC patent family

Abstract of **JP58185767**

PURPOSE: To improve the efficiency of vapor deposition in a method of depositing the vapor formed by conducting electric current on a material, formed by vapor deposition by applying a

specific magnetic field to the vapor.

CONSTITUTION: A pair of electromagnetic coils 5 are disposed oppositely to each other so as to sandwich electrodes 3a, 3a for depositing a material 3, 3 therebetween near a substrate 4 in a high peak pulse arc metallization method wherein, for example, high peak pulse arc current is flowed between the materials 3 and 3. The electrode pair 3a and a coil pair 5 are connected to power source parts 6, 7 for generating vapor deposition current and magnetic field, and the switch 8d in a control part 8 is turned on. Then, the high peak pulse arc current is generated in the part 6 and electric charge is supplied to the coil 5 by the power source 7 with a set delay time by the delay circuit in the control part 8, whereby a magnetic field is generated. As a result, the magnetic force of the substrate 4 is generated in the vapor of the material 3 in accordance with the Fleming's left hand rule and said vapor is deflected in the direction of the substrate 4, whereby vapor deposition effciency is improved.

×

▲ top

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—185767

⑤ Int. Cl.³
C 23 C 13/00

識別記号

庁内整理番号 7537-4K 砂公開 昭和58年(1983)10月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈蒸着方法

3)特

願 昭57-67431

②出 願 昭57(1982)4月23日

⑫発 明 者 二瓶正恭

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 芦田栄次

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 田口文夫

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑫発 明 者 小倉慧

日立市幸町3丁目1番1号株式会社日立製作所日立研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

⑩代 理 人 弁理士 高橋明夫

明 細 📲

発明の名称 燕潜方法

特許請求の範囲

1. 破滅着物の近傍に対向配慮した蒸着物質を配 或し、前記蒸着物質に電流を流して蒸着物質の無 気を形成し、前記蒸着物質の蒸気を前配被蒸着物 に蒸着させる蒸着方法において、前記蒸着物質の 蒸気に電流が流れている状態でかつ前配被蒸着物 の方向に力が動くように該蒸着物質の蒸気に磁界 をかけたことを特敵とする蒸着方法。

発明の辞細な説明

本発明は蒸焙方法に保り、特に被無癌物の近傍 に無層物質を対向配置し、との無層物質に電流を 流して蒸磨物質の蒸気を形成し、この無層物質の 蒸気を被蒸磨物に蒸溜させる無層方法の改良に関 する。

一般に広く用いられている森層方法は、被蒸着物と蒸贈物質とをるつぼ内に収納し、るつぼ内を10⁻¹ Torr 程度の真空にし、無層物質を加熱無発させ、蒸贈物質の対向面に配置した被蒸

層物に無着物質の無気を付着させるものである。 しかし、かかる蒸滑方法においては、るつぼを用いて無着物質を暴発させるため高触点物質の無着ができず、またるつぼ内を高真空中にしなければならず、蒸煮速度が遅い等の問題点がある。

近時、かかる間端点を解消すべく、第1図に示すようにパルス電流を用いた無層方法が提案されている。このパルス電流を用いた無層方法は、アルゴンガス雰囲気中で、対向配置された一対の蒸棄物質3に高ピークパルスアーク電流を流し、蒸棄物質3を瞬時に金属蒸気にし、蒸板4炭面に煮着する方法である。なか、1は電源、2はスインテである。このパルス電流を用いた蒸溜方法を用いれば、上配の問題点を解消することができるという特象を有するが、蒸産物質が蒸発し基板に蒸縮する蒸煮量は約30~40%であり、蒸産効率が悪い、という問題点がある。

本発明は、上記問題点を解消すべくなされたもので、 無着効率を向上させた無滑方法を提供する ことを目的とする。

(1)

 $F = \mu_0 IHB(N)$

......(1)

次に本発明の原理を第2凶を用いて説明する。 強さH(AT/m)の平等磁界に垂直に乗さま(m) の再直な恐体を配置し、この恐体に強さ!(A) のは確を流すと、恐体に加わる力下は、フレミン クの左手の法則に従つて次の(1)式で扱わされる。

(3)

また、尚口庇を流し抵抗加热により抵力する方法においても、パルス磁界を忍妊させて与えることにより、高ピークパルスアークメタライズ方法 と同様の効果が得られることが確認された。

第4図に本発明を袋施するための鉄匠を示す。 との装匠は、茜板4の近傍に対向配匠された一対 のは私3 a を配置しており、この電位3 a のそれ ぞれに蒸燈物質3が挟持されている。また、藍板 4の近傍にはは低3 a を挟むように対向配置され た一対のは磁コイル5が配置されている。

(4)

6 a . 7 a のゲートかよびサイリスタ6 e . 7 e のゲートは、制興部8に接続されている。制御部 8には、ポテンショメータ8a.8b,8c、を よびスイッチBdが設けられている。この制御部 8は、内ピークパルスアーク区抗(区圧)および パルス磁界を制御するための位相点弧回路、パル ス磁外をほピークパルスアーク虹流より湿地させ て発生させるための超越回路を含んで構成されて いる。また、ポテンショメータ8a,8bは、双 方向性サイリスタ6 a. 7 aの点弧位相を変化さ・ せてコンデンサ6d.7dの充立立圧を斟値する ものであり、ポテンショメータ8cは、応ピーク パルスアークは硫とパルス磁界との遅延時間を調 笠するものである。 効作は、 スイッチ 8dをオン させることによりサイリスタ6cがオンし、届ピ ークパルスアークជ优が発生し、ポテンショメー タ8cで設定した時間巡蛛してサイリスタ7eが オンし、コンデンサ7dに充置された耳側が耳曲 コイル5に供給されパルス磁界が発生する。この 始处。フレミングの左手の任則に促つて蒸燈物質

(5)

持開昭58-185767 (3)

の蒸気に基板 4 方向の磁力が発生し、蒸着物質の 蒸気が基板 4 方向に偏向される。

次に、上記袋置を使用した本発明の実施例について説明する。この実施例は、アルミナ系セラミックにモリブデンを蒸着したものである。蒸着条件は、蒸着物質として径0.8 mのモリブデンワイヤを用い、紙ピークパルスアーク電視発生用コンデンサ6 dの容量を1000 m F、放電電圧2500 V とし、パルス磁界用コンデンサ7 dの容量を5000 m F、放電電圧30 V とし、遅延時間を10 m s で行つたものである。蒸着効率は、60 ~ 80%となり、従来の高ピークパルスアークメタライズ方法より2~25倍の蒸着が得られた。

なお、無滑膜の厚さおよび無滑範囲は、パルス 磁界の強さまたは遅延時間を変化させることによ り任意に変更することができる。

以上説明したように本発明によれば、蒸着効率 を同上させることができる、という優れた効果が 得られる。

図面の簡単な説明

(7)

示す線図、第4図は、本発明を実施するための装 成である。 3…蒸療物質、4…茶板、5…電磁コイル。 代理人 弁理士 高橋明夫 でルル

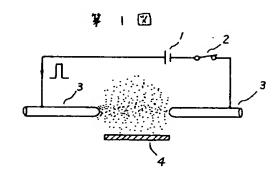
第1図は、高ピークバルスアークメタライズ方

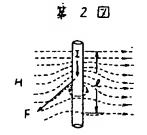
法の原理を説明するための説明図、第2図は、本

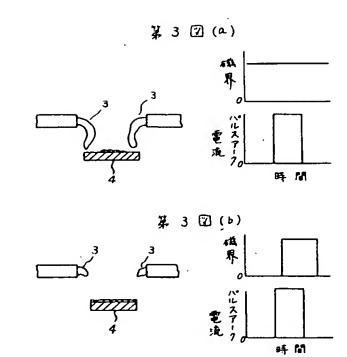
発明の原理を説明するための説明図、第3 図(a) か

よび無3図切は、高ピークパルスアーク電流と曲

界とのタイミングの変化による無着状態の変化を







(8)

